

	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ180P03NS3EGATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 39.6A TSDSON-8</p>
	<p>Datenblätter:  BSZ180P03NS3EGATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 1600 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

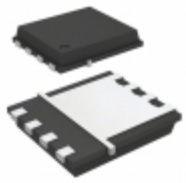
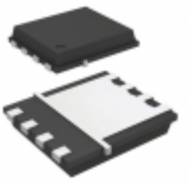


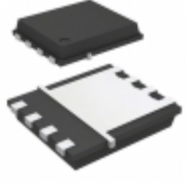
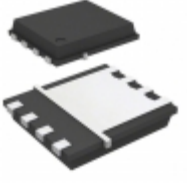

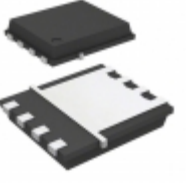
Spezifikationen

Teilenummer	BSZ180P03NS3EGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 39.6A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1600 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.1V @ 48µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 40W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2220pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 39.5A (Tc)

BSZ180P03NS3EGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ180P03NS3EGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ180P03NS3EGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSZ180P03NS3EGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ215CHXTMA1 Infineon Technologies MOSFET N/P-CH 20V 8TSDSON</p>	 <p>BSZ22DN20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 7A 8TSDSON</p>	 <p>BSZ16DN25NS3G INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p>BSZ180P03NS3 G Infineo BSZ180P03NS3 G Infineo</p>
 <p>BSZ240N12NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 37A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ180P03NS3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 39.6A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ180P03NS3E G Infineo BSZ180P03NS3E G Infineo</p>	 <p>BSZ16DN25NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ180P03NS3EGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ180P03NS3EGATMA1 Datenblatt	BSZ180P03NS3EGATMA1-Datenblätter	BSZ180P03NS3EGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
BSZ180P03NS3EGATMA1 Electronic	BSZ180P03NS3EGATMA1-Komponenten	BSZ180P03NS3EGATMA1-Verteiler	BSZ180P03NS3EGATMA1-Bild	BSZ180P03NS3EGATMA1
BSZ180P03NS3EGATMA1 Aktie	BSZ180P03NS3EGATMA1 Inventar	BSZ180P03NS3EGATMA1 Preis	BSZ180P03NS3EGATMA1 Hersteller	BSZ180P03NS3EGATMA1-Teil
BSZ180P03NS3EGATMA1 RFQ	BSZ180P03NS3EGATMA1 Online bestellen	BSZ180P03NS3EGATMA1 Neu	BSZ180P03NS3EGATMA1 Original	BSZ180P03NS3EGATMA1 Bild
				BSZ180P03NS3EGATMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited